

# HBK55J30N

## 硅 N沟道结型场效应管

用于低频放大

用于热释电传感器

特征

高栅极 - 漏极电压

有助于小型化，减少组件数量。

环保无卤素包装

包装：3000个/卷/标准

引脚名称

1：(S)源极

2；(D)漏极

3：(G)栅极

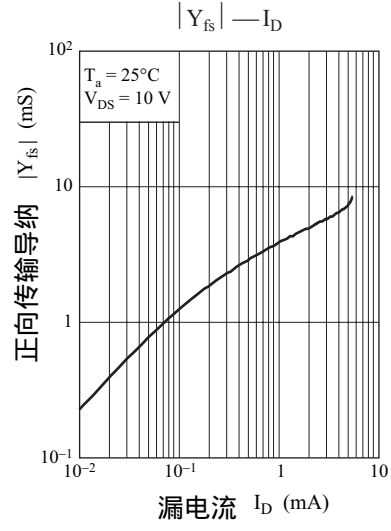
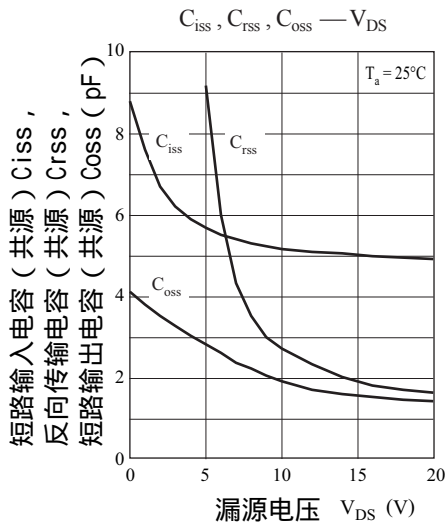
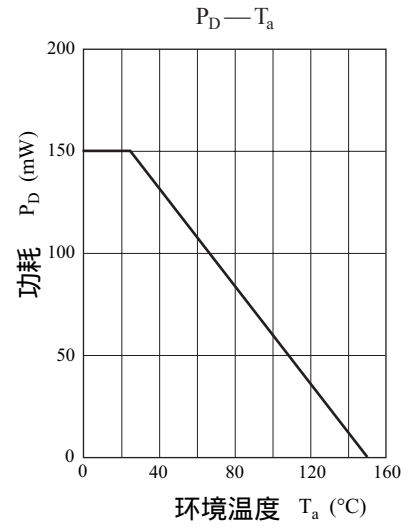
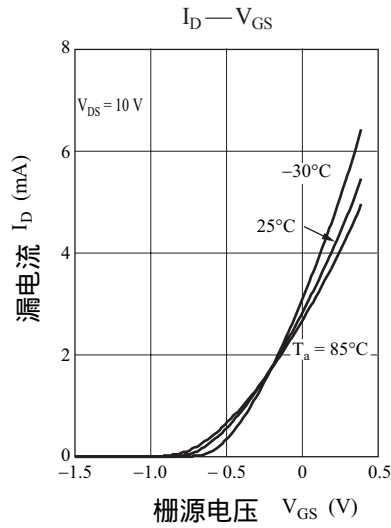
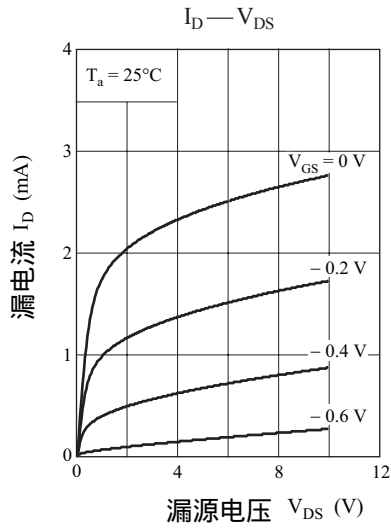
绝对最大额定值  $T_a = 25^\circ\text{C}$

参数/符号	额定	单位
栅极 - 漏极击穿电压 $V_{GDS}$	-55	V
漏电流 $I_D$	30	mA
栅电流 $I_G$	10	mA
功耗 $P_D$	150	mW
通道温度 $T_{ch}$	150	$^\circ\text{C}$
储存温度 $T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

电气特性  $T_a = 25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$

参数/符号	条件	最小值	平均值	最大值	单位
栅极 - 漏极击穿电压 $V_{GDS}$	$I_G = -100 \mu\text{A}, V_{DS} = 0$	-55			V
漏源截止电流 $I_{DSS}$	$V_{DS} = 10 \text{V}, V_{GS} = 0$	1.0		12.0	mA
栅源截止电流 $I_{GSS}$	$V_{GS} = -30 \text{V}, V_{DS} = 0$			-10	nA
栅源截止电压 $V_{GSC}$	$V_{DS} = 10 \text{V}, I_D = 10 \mu\text{A}$			-5	V
正向传输导纳 $Y_{fs}$	$V_{DS} = 10 \text{V}, I_D = 5 \text{mA}, f = 1 \text{MHz}$	2.5	7.5		mS
短路输入电容 (共源) $C_{iss}$	$V_{DS} = 10 \text{V}, V_{GS} = 0, f = 1 \text{MHz}$		6.0		pF
反向传输电容 (通用信号源) $C_{rss}$			2.5		pF

漏源截止电流 $I_{DSS}(\text{ma})$	1.0 to 3.0	2.0 to 6.5	5.0 to 12.0
标记符号	B6P	B6Q	B6R



# SOT-323F

单位: mm

